CREST「次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」領域

第一回公開シンポジウム

物質の魅力的な性質を切り拓く

平成23年11月25日(金) 10:30～17:30（ポスター発表17:00～20:00）

参加費 無料

参加登録をお願いいたします。

※意見交換会への参加は有料(4,000円)となります。

会場のご案内…富士ソフトビル５階アキバホール
http://www.fsi.co.jp/akibaplaza/cont/info/access.html
JR 秋葉原駅中央改札口より徒歩２分／受付開始 10:00～

参加登録方法…参加登録ページ
http://jst-nexteled.sakura.ne.jp/vol1/
よりお申し込み下さい。
事前登録締切…11 月 17 日（木）
定　　員…200 名
定員になり次第、締め切らせていただきます。

主　　催…独立行政法人　科学技術振興機構
協　　賛…社団法人　応用物理学会

～ご挨拶～

学術的・応用的に魅力的な性質を持つ物質は沢山発見・創出されてきましたが、案外エレクトロニクスデバイスへの適用は限定的であり、新物性の導入は容易ではありません。本 CREST 領域では、従来半導体技術の限界が顕在化してきた中で、魅力的な性質を使って次世代エレクトロニクスデバイス事業を切り拓くべく独創的なアプローチで挑戦しております。

第１回の今回の公開シンポジウムでは、平成19年度に採択した５チームの研究代表者に研究成果の概要を出来るだけ易しく発表して戴きます。また、併せて本 CREST 全17チームの最新の研究成果トピックスについてもポスター展示によりご紹介いたします。

基調講演には、日本の科学技術振興のリーダーである JST 北澤宏一理事長に、国力の源泉である科学技術の振興に関するご意見を伺います。また、招待講演として、現在 NEDO 国家プロジェクト「低炭素社会に向けた超低電圧デバイスプロジェクト（LEAP）」を統括されている住広直孝プロジェクトリーダーにその狙いと最近の成果をご紹介していただきます。大変興味深い成果が沢山ございますので、是非ご参加いただきたき活発な意見交換をお願い申し上げます。

CREST「次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」研究領域
研究総括　**渡辺 久恒**

プログラム

10:30～10:40	開会挨拶	研究総括　渡辺　久恒
セッション①	座長：領域アドバイザー　大野　英男　東北大学 教授	
10:40～11:30	【基調講演】	科学技術振興機構 理事長　北澤　宏一
11:30～12:05	「スピン機能 MOSFET とその低消費電力 CMOS 技術への展開」	東京工業大学 准教授　菅原　聡 コメンテーター　ソニー(株) 統括部長　長島　直樹
12:05～13:00	休　憩	
セッション②	座長：領域アドバイザー　百瀬　寿代　(株)東芝 主務	
13:00～13:35	「グラフェン・オン・シリコン」	東北大学 教授　尾辻　泰一 コメンテーター　東京大学 教授　平本　俊郎
13:35～14:10	【招待講演】「超低電圧デバイス技術研究組合における低電力デバイス開発」	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部長　住広　直孝
14:10～14:45	「機能性酸化物を用いた新原理トランジスタの実証～金属 / 絶縁体相転移を電界で制御する試み～」	産業技術総合研究所 センター長　秋永　広幸 コメンテーター　東京大学 教授　川崎　雅司
14:45～15:15	休　憩	
セッション③	座長：領域アドバイザー　財満　鎭明　名古屋大学 教授	
15:15～15:50	「最先端 LSI 開発を支える真空紫外レーザー光発生用結晶」	大阪大学 特任教授　佐々木孝友 コメンテーター　東京大学 教授　近藤　高志
15:50～16:25	「EUV レジストの反応機構の解明と高性能化への道筋」	大阪大学 特任教授　田川　精一 コメンテーター　(株)東芝 研究主幹　大西　廉伸
16:25～16:50	講評	研究総括　渡辺　久恒
17:00～20:00	ポスター発表　CREST「次世代デバイス」領域　17 チーム	
18:00～20:00	意見交換会	

シンポジウムに関するお問い合わせ
東京都千代田区三番町５番地　三番町ビル　独立行政法人科学技術振興機構
CREST「次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」領域
遠藤伸裕　Tel：03-3512-3538　E-Mail：nendo@nexteled.jst.go.jp

独立行政法人 科学技術振興機構 Japan Science and Technology Agency

平成 23 年 9 月 15 日現在